Анализ механизма увеличения эффекта Керра в Mn/Dy/Bi

© С.Г. Овчинников, Л.В. Буркова, В.А. Середкин, В.Ю. Яковчук

Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, 660036 Красноярск, Россия

E-mail sgo@iph.krasnoyarsk.su

(Поступила в Редакцию 2 июня 1998 г.)

Приведены результаты исследований структурных, магнитных и магнитооптических свойств пленок Mn/Dy/Bi, полученных с помощью мультислойной технологии. Показано, что в таких пленках максимальный угол вращения Керра равен $\theta_k=2.25^\circ$. Рассмотрены возможные причины столь значительного увеличения эффекта Керра: увеличение вероятности 6p-3d-переходов вследствие искажения симметрии, поляризация 6p-зоны Bi, изменение плотности состояний вблизи уровня Ферми. Проведен анализ последней причины с помощью моделирования электронной структуры Mn/Dy/Bi наложением уровней Dy на зонную структуру MnBi, что позволило выявить возможные дополнительные переходы, которые могут возникать в результате введения прослойки Dy и давать вклад в магнитооптический эффект Керра.

Поликристаллические пленки МпВі являются одним из первых материалов [1], в которых был обнаружен большой эффект Керра при комнатной температуре $(\theta_k = 0.7^\circ)$ [2]. В пленках Mn/Dy/Bi, получаемых в последнее время с использованием мультислойной технологии, наряду с уменьшением среднего размера кристаллитов до 15 nm и увеличением перпендикулярной анизотропии получен угол вращения 2.25° [3], что представляет значительный как научный, так и практический интерес. Экспериментальные результаты показывают, что при введении в объем пленки примесей, например, Ti [4], Zn, Te [5], Sb [6], V, Cr, Cu, Ni [7], Ag, Au, In, Pt [8], а также Dy [9] происходит ухудшение магнитооптических (MO) свойств. Допирование Al [8,10] приводит к увеличению эффекта Керра до 2°, однако при этом уменьшается перпендикулярная анизотропия в 2 раза. Использование в качестве примеси Sm, Ce, Pr [11] позволяет получить угол вращения $2-2.5^{\circ}$, но при этом коэффициент прямоугольности петли гистерезиса меньше единицы.

Результаты самосогласованного вычисления спинполяризованной зонной структуры МпВі, в котором спин-орбитальное взаимодействие рассматривалось как возмущение, показали, что основной вклад в магнитооптический эффект должны вносить переходы $\mathrm{Bi}\,6p\downarrow \to \mathrm{Mn}\,3d\downarrow [12]$. Релятивистский расчет электронной структуры в приближении локального функционала плотности методом присоединенных сферических волн (LDA-ASW) позволил получить спектральную зависимость эффекта Керра МпВі, которая хорошо согласуется с экспериментом [13,14]. Использование такого подхода при анализе микроскопической природы эффекта Керра в МпВі дало возможность авторам объяснить причину его больших значений сочетанием значительного магнитного момента на Мп, большой спин-орбитальной связи Ві, которая, как считается, в 10 раз больше, чем в 3d-металлах [15], и сильной гибридизации между *d*-зоной Mn и *p*-состояниями Bi [14]. Теоретическое рассмотрение влияния примесей на эффект Керра [13,16] показывает, что их наличие приводит к изменению намагниченности Мп и спин-орбитальной связи Ві [16], к перераспределению плотности состояний вблизи уровня Ферми, оказывает влияние на гибридизацию [13,16], а величина МО эффекта в значительной степени зависит от положения атомов примеси в элементарной ячейке МпВі [13]. Последний вывод согласуется с результатами вычислений в рамках кластерной модели [17]. Анализ экспериментальных данных дает основание предполагать, что соотношение вклада рассматриваемых причин в эффект Керра определяется спецификой вводимой примеси [8,11].

В данной работе приводятся результаты исследований структурных, магнитных, магнитооптических свойств пленок Mn/Dy/Bi и анализируется механизм наблюдаемого в них значительного увеличения эффекта Керра ($\theta_k=2.25^\circ$).

1. Образцы и методика эксперимента

Пленки Mn/Dy/Bi изготовлялись последовательным осаждением чередующихся слоев Bi, Dy, Mn, Dy и т.д. на стеклянные подложки при комнатной температуре в вакууме $3 \cdot 10^{-6}$ Torr [18]. Сразу после испарения образцы отжигались в вакууме $5 \cdot 10^{-6}$ Torr при температуре $250-270^{\circ}$ С. Длительность отжига выбиралась 60, 30, 15 и 7 min в зависимости от толщины и количества слоев [19]. Толщины слоев Bi и Mn выбирались таким образом, чтобы выполнялось атомное соотношение 1:1, и изменялись в пределах 12.5-100 nm для Bi, 4-39 nm для Mn. Толщина Dy выбиралась в интервале от 3 до 40 nm.

Структурные свойства пленок изучались с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Химический состав и толщина образцов определялись с помощью спектрального флюоресцентного анализа. Ожеспектры позволили получить распределение компонентов по толщине. Анализ химических связей проводился на основе рентгеновских фотоэлектронных спектров. Намагниченность насыщения (M_s) и константа перпендикулярной анизотропии (K_u) определялись на торсионном магнитометре. Угол вращения полярного эффекта

Керра (θ_k) и его спектральные зависимости снимались со стороны подложки при комнатной температуре на магнитооптической установке в полях до $16\,\mathrm{kOe}$. Коэрцитивная сила (H_c) определялась из керровских петель гистерезиса.

2. Экспериментальные результаты

В результате оптимизации по толщине и количеству слоев в исходном состоянии были получены пленки Mn/Dy/Bi с параметрами: средний размер кристаллитов 15 nm, $H_c = 6 \, \mathrm{kOe}$, $K_u = 1 \cdot 10^7 \, \mathrm{erg/cm^3}$, $\theta_k = 2.25^\circ$ при $\lambda = 633 \, \mathrm{nm}$. Эти пленки до отжига состояли из чередующихся слоев Bi, Dy и Mn толщиной 49.5, 5 и 17 nm соответственно, с общим количеством слоев, равным 7. Их отжиг проводился при температуре 270°C в течение 30 min.

Сравнительный анализ кристаллической структуры таких пленок и пленок МпВі, полученных нами по обычной технологии [20], показывает, что значительное уменьшение размера кристаллитов в первых является следствием введения Dy в виде прослойки. В пленках MnBi после отжига наблюдается большое количество крупных кристаллитов размером 250-400 nm, отдельные кристаллиты имеют размер 1000-3000 nm. В оптимальных по структурным свойствам пленках Mn/Dy/Bi средний размер кристаллитов в результате отжига уменьшается с 300 до 15 nm, т.е. почти на два порядка по сравнению с MnBi. Электронограммы пленок Mn/Dy/Bi до отжига показывают поликристаллическое состояние Ві, Dy и Mn, при этом средний размер кристаллитов Bi и Mn примерно 300 nm, а размер кристаллитов Dy на порядок меньше. После отжига кроме образовавшейся фазы MnBi остается небольшая объемная доля Мп и Ві в свободной фазе. Объемная доля чистого Dy в результате отжига значительно уменьшается, что может быть обусловлено его вхождением в кристаллическую решетку МпВі. Возможно также образование соединений Dy с кислородом и/или с окисью Мп, что подтверждается наличием рефлекса DyMnO₃ на электронограммах и следует из рентгеновских фотоэлектронных спектров. Эти спектры

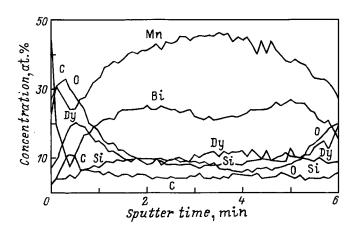


Рис. 1. Оже-профиль пленки Mn/Dy/Bi.

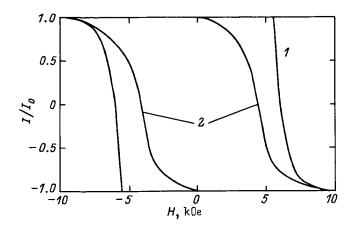


Рис. 2. Петли гистерезиса пленок Mn/Dy/Bi (1) и MnBi (2).

показывают, что Ві и Мп в металлическом состоянии, а Dy как в металлическом, так и окисленном состоянии.

На рис. 1 представлен Оже-профиль пленки Mn/Dy/Bi, который показывает, что распределение каждого компонента в объеме пленки достаточно однородно. Повышенное содержание кислорода и диспрозия в приповерхностной и в приподложечной областях можно объяснить характерной для РЗ-элементов тенденцией мигрировать к поверхности пленки и там подвергаться окислению [21].

Детальное рассмотрение особенностей структурных свойств пленок Мп//Dy/Ві в сравнении с пленками МпВі позволяет сделать вывод, что использование мультислойной технологии способствует формированию мелкокристаллической структуры [3]. Допирование Dy именно с помощью введения соответствующей прослойки способствует более однородному распределению атомов Dy в объеме пленки при отжиге и их вхождению в кристаллическую решетку, причем есть основание предполагать, что с большей вероятностью они должны занимать промежуточные положения в элементарной ячейке МпВі и/или замещать Ві [11], но не Мп [4]. Не исключается и то, что незначительная часть Dy не будет участвовать в образовании твердого раствора и выделится в отдельную фазу. Эта фаза при небольших количествах вводимой примеси, по-видимому, будет распределяться по границам кристаллитов МпВі, а при больших количествах будут образовываться включения из чистого Dy.

На рис. 2 изображена петля гистерезиса пленки Mn/Dy/Bi с оптимальными параметрами, снятая при комнатной температуре. Сравнение с приведенной на этом же рисунке петлей гистерезиса пленки MnBi, полученной нами по обычной технологии, показывает, что в результате введения прослойки Dy значительно улучшается прямоугольность петли гистерезиса, которая для всех полученных пленок Mn/Dy/Bi равна единице. В табл. 1 приведены магнитные и магнитооптические параметры пленок Mn/Dy/Bi, имевших различные толщины и количество слоев до отжига. Приведены также

	Толщина			Общее	Время	п	M_s ,	$K_u \cdot 10^{-7}$,	Δ
Состав	Bi, nm	Mn, nm	Dy, nm	количество слоев	отжига, min	H_c , kOe	G	$\operatorname{erg}/\operatorname{cm}^3$	$ heta_k, ext{deg}$
Mn/Dy/Bi	49.5	17	5	3	30	2	485	1	1.5
Mn/Dy/Bi	49.5	17	20	3	60	5	-	_	1.4
Mn/Dy/Bi	50	18	4	7	30	1.6	520	1.2	1.9
Mn/Dy/Bi	104	39	5	3	60	4.7	320	0.7	1.0
Mn/Dy/Bi	49.5	17	5	7	30	6	330	1.4	2.25
MnBiDy		148			30	8			0.35
MnBi	148				60	3.5	400	1.4	1.3
MnBi [13]	148				300	0.8	620	20	0.7

Таблица 1. Магнитные и магнитооптические свойства пленок Mn/Dy/Bi, MnBiDy и MnBi

параметры пленок MnBiDy и MnBi, полученных нами по обычной технологии, и литературные данные для последних. Как видно из таблицы, для всех пленок Мп/Dy/Ві угол вращения Керра значительно больше, чем опубликованные значения для МпВі. Максимальное значение $\theta_k = 2.25^\circ$ имеют отмеченные выше пленки с оптимальными параметрами. В пленках, полученных нами с помощью обычного введения примеси Dy в эквивалентном процентном соотношении, угол МО вращения значительно меньше и составляет 0.35° (табл. 1). На рис. 3 представлена спектральная зависимость θ_k для пленок Mn/Dy/Bi, которая имеет максимум в области длин волн $\lambda = 633 \, \text{nm}$. Видно, что этот максимум несколько смещен в сторону более коротких длин волн по сравнению с зависимостью для пленок МпВі, которая также представлена на этом рисунке.

3. Обсуждение результатов

Обращает на себя внимание большой угол вращения Керра в пленках Mn/Dy/Bi, максимальное значение которого более чем в 1.5 раза превосходит значение для пленок MnBi, полученных нами (табл. 1). Как указывалось выше, вращение Керра зависит от спинорбитальной связи, намагниченности и плотности состояний [15]. Проведенные нами измерения показали, что намагниченность пленок Mn/Dy/Bi примерно на 30%

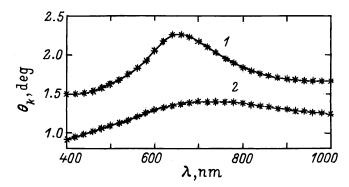


Рис. 3. Дисперсионные зависимости θ_k пленок Mn/Dy/Bi (*I*) и MnBi (*2*).

меньше, чем в полученных нами пленках MnBi. Это в немалой степени может быть связано с возникновением мелкокристаллической структуры [17]. Расчеты показывают, что при введении примеси, например Al в MnBi, происходит уменьшение спин-орбитального взаимодействия из-за гибридизации состояний примеси и Bi [16]. Поэтому маловероятно, что две первые причины могут вносить вклад в увеличение θ_k , и таковую следует искать в изменении электронной структуры, которое происходит в результате введения прослойки Dy.

Чтобы более ясно представить механизм усиления эффекта Керра, необходимо рассмотреть зонную структуру MnBi [12], расчет которой дает картину плотности состояний, изображенную на рис. 4, a–c. Как видно из рисунка, наибольшая вероятность оптических переходов связана с переходами $\text{Bi}\,6p\,\downarrow\to\text{Mn}\,3d\,\downarrow$ с энергией 1.5–2 eV. Количественные расчеты подтверждают этот вывод [13,14]. Вычисленная спектральная зависимость имеет максимум при $1.8\,\text{eV}$, что согласуется как с нашими (рис. 3), так и с опубликованными другими авторами экспериментальными данными.

При феноменологическом рассмотрении угол вращения Керра определяется недиагональным членом тензора оптической проводимости [15]

$$\theta_k = \frac{4\pi}{\omega} \operatorname{Re} \left[\frac{\sigma_{xy}}{\left(1 - (n + ik)^2 \right) (n + ik)} \right], \tag{1}$$

где n+ik — комплексный показатель преломления на частоте ω . Для объяснения большого эффекта Керра в пленках Mn/Dy/Bi предлагается несколько причин микроскопического уровня, которые могут привести к увеличению σ_{xy} при введении прослойки Dy.

1) Как отмечалось выше, к большому эффекту Керра в MnBi приводят электронные переходы 6p-3d (см. рис. 4,a-c), матричные элементы которых входят в σ_{xy} . Введение атомов Dy в решетку MnBi может приводить к искажению симметрии и обусловленному этим возрастанию вероятности 6p-3d-переходов, т. е. к увеличению их матричных элементов. Искажение симметрии происходит, если атомы примеси занимают промежуточные положения в элементарной ячейке MnBi [13]. Как отмечалось выше, атомы Dy в пленках Mn/Dy/Bi с большей

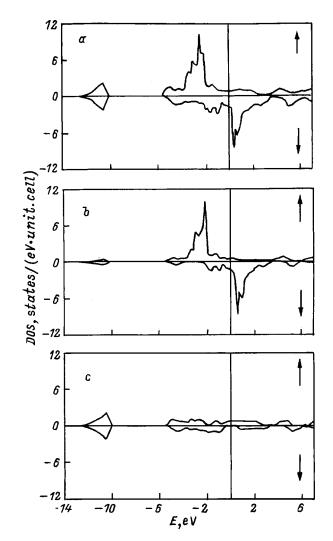


Рис. 4. Плотности состояний MnBi [12]. a — суммарная плотность состояний, b — плотность 3d Mn-состояний, c — плотность 6p Bi-состояний. Вертикальные стрелки на рис. 4–6 обозначают направления спинов.

вероятностью занимают промежуточные положения, и это может быть одной из причин увеличения эффекта Керра. В пленках МпВіDу, полученных нами с помощью одновременного осаждения компонентов, что больше способствует замещению атомов Мп [4] атомами Dy, величина θ_k значительно меньше (табл. 1).

2) Недиагональный член тензора оптической проводимости может быть разложен на члены, зависящие от ориентации спинов электронов [15],

$$\sigma_{xy} = \sigma_{xy}(\uparrow\uparrow) + \sigma_{xy}(\downarrow\downarrow) + \sigma_{xy}(\uparrow\downarrow) + \sigma_{xy}(\downarrow\uparrow). \quad (2)$$

Сравнение энергетических зависимостей этих членов показывает, что переходы с перемешиванием спинов дают незначительный вклад, а расчеты показывают [13], что магнитооптический переход в MnBi главным образом определяется переходами из 6p-состояния Bi со спином вниз в 3d-Mn со спином вниз. Из рис. 4, b видно, что 3d-зона Mn полностью поляризована и примеси на нее не должны оказывать заметного влияния. Анализ электронной структуры пленок MnBiAl позволил сделать вывод, что при добавлении Al происходит значительная поляризация 6p-зоны Bi, т. е. увеличивается количество 6p-электронов со спином вниз и дырок со спином вверх, и это должно приводить к увеличению MO эффекта [17]. Подобным образом может действовать Dy в пленках Mn/Dy/Bi. Возможным механизмом такого воздействия может быть гибридизация 4f- и 5d-состояний Dy с 6p-состояниями Bi (рис. 4, c), увеличивающая плотность состояний последнего ниже уровня Ферми, что, в свою очередь, должно привести к увеличению вероятности оптических переходов.

3). Для обсуждения эффекта Керра в Mn/Dy/Bi можно смоделировать электронную структуру этой системы наложением уровней Dy на зонную структуру MnBi. В соединении s- и d-электроны P3 атома образуют металлическую связь, а 4f-электроны, по-видимому, могут рассматриваться в однопримесном приближении, как совокупность изолированных (без учета гибридизации с Мп и Ві) локальных термов. Эти термы могут сдвинуться относительно чистого металла. Согласно данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS), такой сдвиг зависит от процентного содержания РЗ-элемента [22] и, например, для аморфных пленок Тb₂₁Fe₇₉ составляет примерно 1 eV [23]. По мнению авторов, причиной смещения может быть гибридизация между d-состояниями Fe и Tb. В спектре $Tb_{21}Fe_{79}$ существует низкоэнергетический максимум с энергией связи 2-3 eV, соответствующий 4f-электронам Тв. В области малых энергий связи $E_b \approx 1 - 3\,\mathrm{eV}$ основной вклад в плотность состояний РЗ-элемента вносят 5*d*-электроны (что также подтверждается XPS-данными для чистых РЗ [24]), обеспечивающие максимум в оптической проводимости $\sigma(\omega)$ при $h\omega \approx 2\,\mathrm{eV}$ [25]. Поскольку переходы $P3 \ 5d \rightarrow Mn \ 3d$ запрещены оптическими правилами отбора, *d*-состояния РЗ-элемента несущественны с точки зрения оптических переходов.

В пленках Mn/Dy/Bi 4f-электроны находятся в ферромагнитной матрице и могут быть подмагничены за счет s-f-обменного взаимодействия. Однако в этом случае, в отличие от чистых РЗ металлов, где определяющим является внутриатомное s-f-объемное взаимодействие $J_{s-f} \sim 1 \,\mathrm{eV}$ [26], имеет место также и взаимодействие спинов 4f-электронов с зонными электронами Мп, которое на порядок меньше. Поэтому можно пренебречь обменным расщеплением 4f-уровней и модель зонной структуры Mn/Dy/Bi можно представить как наложение на рис. 4, а плотности состояний Dy. Вследствие отсутствия в литературе данных о плотности состояний Dy в соединении, для этой цели можно воспользоваться локальной плотностью состояний Ть [27], выведенной непосредственно из XPS и XPS⁻¹ спектров для Тb₂₁Fe₇₉ [23]. Такая плотность с учетом общего вида вычисленной плотности состояний ферромагнитного Gd [28] изображена на рис. 5, a штриховыми и штрихпунктирными линиями для 4f- и 5d-электронов

Таблица 2. Возможные переходы в пленках Mn/Dy/Bi при параллельной ориентации спинов Dy и Mn

N _Ω π/π	Возможные переходы	Энергия перехода	Интервал вклада перехода, nm
1	$5d \uparrow \rightarrow 6p \uparrow$	$\Delta E > 0$	400-1000
2	$5d \downarrow \rightarrow 6p \downarrow$	$\Delta E > 0$	400-1000
3	$6p \uparrow \rightarrow 5d \uparrow$	$0 < \Delta E < E_{5d\uparrow}$	770-1000
4	$6p \downarrow \rightarrow 5d \downarrow$	$0 < \Delta E < E_{5d\downarrow}$	770-1000
5	$4f \uparrow \rightarrow 6p \uparrow$	$\Delta E > E_{f\uparrow}$	400-860
6	$4f \uparrow \rightarrow 3d \uparrow$	$\Delta E > E_{f\uparrow}$	400-860
7	$4f \uparrow \rightarrow 5d \uparrow$	$E_{f\uparrow}+E_{5d\uparrow}>\Delta E>E_{f\uparrow}$	400-860
8	$6p \downarrow \rightarrow 4f \downarrow$	$E_{f\downarrow} + \Delta E_{f\downarrow} > \Delta E > E_{f\downarrow}$	400-860
9		$E_{f\downarrow} + \Delta E_{f\downarrow} > \Delta E > E_{f\downarrow}$	400-860
10		$ E_{f\downarrow} + \Delta E_{f\downarrow} > \Delta E > E_{f\downarrow} $	400-860

Таблица 3. Возможные переходы в пленках Mn/Dy/Bi при антипараллельной ориентации спинов Dy и Mn

N ₂ π/π	Возможные переходы	Энергия перехода	Интервал вклада перехода, nm
1	$5d \uparrow \rightarrow 6p \uparrow$	$\Delta E > 0$	400-1000
	$5d \downarrow \rightarrow 6p \downarrow$	$\Delta E > 0$	400-1000
3	$6p \uparrow \rightarrow 5d \uparrow$	$0 < \Delta E < E_{5d\uparrow}$	770-1000
4	$6p \downarrow \rightarrow 5d \downarrow$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	770-1000
5	$4f \downarrow \rightarrow 6p \downarrow$	$\Delta E > E_{f \downarrow}$	400-860
6	$4f \downarrow \rightarrow 3d \downarrow$	$E_{f\downarrow} + E_{3d\downarrow} +$	560-730
		$+\Delta E_{3d\downarrow} > \Delta E > E_{f\downarrow} + E_{3d\downarrow}$	
7	$4f \downarrow \rightarrow 5d \downarrow$	$E_{f\downarrow} + E_{5d\downarrow} > \Delta E > E_{f\downarrow}$	400-860
8	$6p \uparrow \rightarrow 4f \uparrow$	$E_{f\uparrow} + \Delta E_{f\uparrow} > \Delta E > E_{f\uparrow}$	400-500
9	$3d \uparrow \rightarrow 4f \uparrow$	$E_{f\uparrow} + \Delta E_{f\uparrow} > \Delta E > E_{f\uparrow}$	400-500
10	$5d \uparrow \rightarrow 4f \uparrow$	$E_{f\uparrow} + \Delta E_{f\uparrow} > \Delta E > E_{f\uparrow}$	400-500

при температуре T = 0. Здесь уже учтен эффект гибридизации 4f- и 5d-электронов Dy с 3d-электронами Mn. Рассмотрен случай параллельной ориентации спинов Dy и Мn, т.е. $M_{\mathrm{Dy}} \uparrow \uparrow M_{\mathrm{Mn}}$ и $J_{df} > 0$. Предполагается, что спиновое расщепление 5d-зоны Dy отсутствует или очень мало. В рамках предложенной модели из рис. 5, а можно определить, какие дополнительные переходы, вносящие вклад в увеличение эффекта Керра, могут возникнуть из-за введения Dy. Такие переходы перечислены в табл. 2. Исходя из рис. 4 и 5, а, можно ориентировочно оценить предполагаемые вклады от этих переходов. Переходы под номерами 1, 4, 5, 8 не должны давать вклад вследствие того, что плотность 6*p*-состояний уже должна быть реализована через переходы, которые наблюдаются в MnBi, т.е. через переходы Bi6p-Mn3d. Очень незначительна интенсивность перехода 6, поскольку низка плотность незанятых 3d-состояний Mn со спином вверх. Вклады от остальных переходов примерно одного порядка. Из этих рисунков можно определить ограничения энергии каждого из переходов, которые также приведены в табл. 2. Под энергией перехода ΔE подразумевается разность энергий конечного и начального состояний. Индекс E_i обозначает ближайший к уровню Ферми край зоны плотности і-состояний.

В табл. 3 приведены аналогичные данные для случая антипараллельной ориентации спинов Dy и Mn. Картина плотности состояний для этого случая представлена на рис. 5, b. Рисунок позволяет определить, что переходы под номерами 1 и 4 не вносят вклада по указанной выше причине. Переходы № 2, 3, 5, 7–9 имеют интенсивности примерно одного порядка, поскольку плотности соответствующих им начальных и конечных состояний отличаются незначительно. Ощутимый вклад может быть от перехода под номером 10. Обращает на себя внимание переход $4f\downarrow \rightarrow 3d\downarrow$, который при соответствующей реализации может проявиться как сильный переход.

Количественную оценку пределов для энергии возможных переходов можно сделать с учетом того, что границы 4f-зон Dy могут отличаться от приведенных на рис. 5, a, b для Tb. Опубликованные данные рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии свидетельствуют о том, что в соединении RE Fe $_2$ максимум плотности 4f-состояний Dy ближе к уровню Ферми, чем для Tb [29]. В табл. 2 и 3 приведены интервалы вклада возможных переходов, которые были определены в предположении, что зона заполненных 4f-состояний смещена в сторону уровня Ферми всего на $1\,\mathrm{eV}$ по сравнению с изображенной на рис. 4 и 5, a, т.е. $E_{f\downarrow}=-1.4\,\mathrm{eV}$, а остальные величины в соответствии с рисунком будут: $E_{3d\downarrow}=0.3\,\mathrm{eV}$, $\Delta E_{3d\downarrow}=0.5\,\mathrm{eV}$, $E_{f\uparrow}=2.6\,\mathrm{eV}$, $\Delta E_{f\uparrow}=3\,\mathrm{eV}$. Следует отметить, что одновременно с указанным смещени-

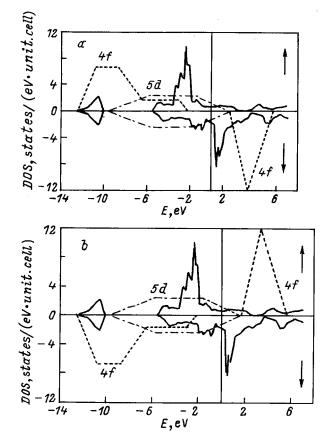


Рис. 5. Суперпозиция плотности состояний MnBi и Dy при параллельной (a) и (b) ориентации спинов Mn и Dy.

ем должно происходить примерно такое же смещение 4f-зоны незаполненных состояний в сторону больших энергий [27]. При этом исчезнут вклады от переходов, в которых конечным состоянием являются незаполненные 4f-состояния.

Как видно из табл. 2, в случае $M_{\mathrm{Dy}} \uparrow \uparrow M_{\mathrm{Mn}}$ вклады от возможных переходов должны быть равномерно распределены в рассматриваемом интервале длин волн 400-1000 nm. Интенсивности этих переходов примерно одного порядка, т.е. они могут приводить только к общему смещению спектральной кривой в область более высоких значений θ_k и не могут определять наблюдаемого для Mn/Dy/Bi смещения максимума по шкале энергий, который остается обеспеченным переходами ${
m Bi}\,6p\!\downarrow \,
ightarrow \,{
m Mn}\,3d\!\downarrow \,$, как в MnBi. Для случая $M_{
m Dy}\downarrow\uparrow M_{
m Mn}$ получается примерно такая же картина. Однако реализуемый при этом переход $4f\downarrow \rightarrow 3d\downarrow$ должен давать значительный вклад в интервале длин волн, который будет определяться шириной пика незаполненных $3d\downarrow$ состояний Мп и в данном случае соответствует интервалу наблюдаемого максимума эффекта Керра. К сожалению, нет данных, позволяющих говорить о взаимной ориентации спинов Dy и Mn, а наблюдаемое в пленках Мn/Dy/Ві уменьшение намагниченности нельзя рассматривать как свидетельство их антипараллельной ориентации, поскольку оно может быть обусловлено уменьшением размера кристаллитов [17].

В соединениях Мп с Dv наблюдается как ферромагнитное [30], так и антиферромагнитное [31] упорядочение спинов этих элементов, причем магнитные свойства в значительной степени зависят от расстояния между атомами [32]. Можно предположить, что, как и в соединениях RE (Fe, Co) [33], упорядочение меняется от антиферромагнитного к ферромагнитному при увеличении расстояния между атомами РЗ и Мп. Если атомы Dy входят в промежуточные положения элементарной ячейки МпВі, расстояние между атомами Мп и Dy больше, чем при замещении ими атомов Ві, т. е. во втором случае более вероятно антиферромагнитное упорядочение. Как уже отмечалось, положения Dy зависят от технологии введения этого элемента, следовательно, наблюдаемые в эксперименте отличия МО свойств пленок Mn/Dy/Bi и MnBiDy можно попытаться объяснить тем, что эти пленки в определенной степени различаются взаимным упорядочением спинов Мп и Dy и соответствующими ему вкладами рассмотренных выше переходов.

В случае $M_{\rm Dy} \uparrow \uparrow M_{\rm Mn}$, если зона незаполненных 4f-состояний достаточно узкая, то максимум эффекта Керра можно объяснить переходами в эту зону. Интервал вклада указанных переходов будет определяться шириной пика незаполненных 4f-состояний и, например, в случае $E_{f\downarrow}=1.6\,{\rm eV}$, соответствующем рис. 6,a, и при $\Delta E_{f\downarrow}\sim 0.8\,{\rm eV}$ становится 520–770 nm. Следовательно, такие переходы могут привести к возникновению наблюдаемого как раз в этом интервале длин волн максимуму θ_k . Вычисления электронной структуры, проведенные с помощью максимально локализованного

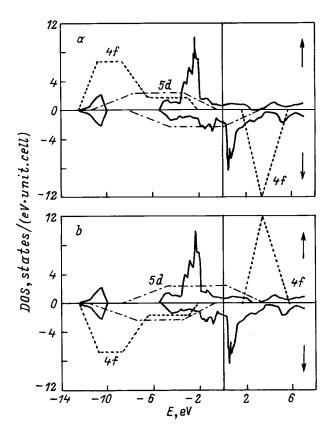


Рис. 6. Суперпозиция плотности состояний MnBi и Dy с учетом спинового расщепления 5d зоны Dy при параллельной (a) и антипараллельной (b) ориентации спинов Mn и Dy.

LMTO метода на основе приближения атомных сфер и рекурсивного метода, показали, что локализация и ширина пика незаполненных 4f-состояний в аморфных пленках "редкая земля—переходной металл" зависят от типа РЗ [34]. Кроме того, было показано, что если изменять расстояние между атомами в пределах от 1 до 2% при одинаковом атомном содержании, то этот пик будет смещаться на $0.3 \, \mathrm{eV}$. Следовательно, существует возможность менять ширину и локализацию пика незаполненных 4f-состояний с помощью выбора соответствующего состава.

На рис. 6, a, b изображены плотности состояний с учетом спинового расщепления 5d-зоны для случая $J_{\rm MnDy}>0$ и $J_{\rm MnDy}<0$ соответственно. Хотя расщепление >4 eV маловероятно [35], однако на этих рисунках для наглядности изображен именно такой предельный вариант. Оценка интенсивности дополнительных переходов при расщеплении показывает, что в случае $M_{\rm Dy}\uparrow\uparrow M_{\rm Mn}$ исчезают переходы с конечным состоянием $5d\uparrow$ (переходы 3, 7, табл. 2) и в случае $M_{\rm Dy}\downarrow\uparrow M_{\rm Mn}$ — с конечным состоянием $5d\downarrow$ (переходы 4, 7, табл. 3). Поскольку эти переходы в совокупности перекрывают весь рассматриваемый интервал длин волн, то можно считать, что в обоих случаях происходит общее снижение спектральной кривой, хотя можно отметить некоторое увеличение интенсивности для переходов с начальным состоянием

 $5d\downarrow(10)$ в первом случае и с начальным состоянием $5d\uparrow$ — во втором (10). Все остальные переходы не изменяются.

Более подробное рассмотрение случая $M_{\mathrm{Dy}} \uparrow \uparrow M_{\mathrm{Mn}}$ (см. рис. 6, a) показывает, что влияние расщепления зависит от температуры. С температуры $5d \uparrow$ зона смещается по направлению к уровню Ферми и при некоторой температуре $T = T^*$ пересекает его. При температуре $T > T^*$ появляются исчезнувшие в результате расщепления переходы: $\mathrm{Bi}\,6p\!\uparrow \to \mathrm{Dy}\,5d\!\uparrow, \quad \mathrm{Dy}\,4f\!\uparrow \to \mathrm{Dy}\,5d\!\uparrow \quad$ и при этом наблюдается рост проводимости. Аналогичным образом происходит в случае $M_{\rm Dy}\downarrow\uparrow M_{\rm Mn}$ (см. рис. 6, b), т. е. при $T=T^*$ появляются исчезнувшие переходы: $6p\!\downarrow \, o \, 5d\!\downarrow$ и $4f\downarrow \rightarrow 5d\downarrow$, в результате чего происходит общее смещение спектральной кривой θ_k в область более высоких значений.

Таким образом, предложенное модельное рассмотрение позволяет детально проанализировать вклад в МО эффекта возможных дополнительных переходов, которые могут появиться в результате введения примеси Dy. Можно сделать вывод о том, что, если в пленках Mn/Dy/Bi положение зоны заполненных 4f-состояний Dy достаточно близко к уровню Ферми, максимум в спектре θ_k может возникнуть только в случае антипараллельной ориентации спинов Dy и Mn и основной вклад в него будут вносить переходы $4f\downarrow \rightarrow 3d\downarrow$. Если зона незаполненных 4f-состояний узкая и достаточно близка к уровню Ферми, максимум в спектре возможен за счет новых переходов только в случае параллельной ориентации. В него могут давать вклад переходы: $6p\downarrow \to 4f\downarrow,\ 3d\downarrow \to 4f\downarrow,\ 5d\downarrow \to 4f\downarrow.$ Как отмечалось выше, смещение зоны незаполненных 4f-состояний к уровню Ферми должно сопровождаться соответствующим сдвигом края зоны заполненных 4f-состояний в сторону больших энергий связи [27], и эта зона (т.е. переходы $4f\downarrow \rightarrow 3d\downarrow$) может определить максимум эффекта Керра, наблюдаемый в коротковолновой области [13]. Спиновое расщепление 5*d*-зоны приводит к общему снижению спектральной кривой θ_k , которая с ростом температуры опять поднимается.

Предложенное рассмотрение причин увеличения эффекта Керра в пленках Mn/Dy/Bi носит предварительный характер. Планируемые в дальнейшем структурные исследования таких пленок, а также теоретические расчеты с учетом различного положения атомов Dy в элементарной ячейке MnBi, изучение оптических и магнитооптических свойств в более широком интервале длин волн и при различных температурах в совокупности с результатами XPS-анализа позволят подтвердить влияние перечисленных причин на эффект Керра и, с другой стороны, количественно определить вклад каждой из них в его увеличение.

Авторы благодарят И.С. Эдельман за полезное обсуждение результатов.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 98-02-16139).

Список литературы

- [1] H.J. Williams, R.C. Sherwood, F.G. Foster, E.M. Kelley. J. Appl. Phys. **28**, *10*, 1181 (1957).
- [2] K. Egashira, T. Yamada. J. Appl. Phys. 45, 8, 3643 (1974).
- [3] Л.В. Буркова, А.С. Паршин, В.А. Середкин, В.Ю. Яковчук. Автометрия **2**, 39 (1995).
- [4] W.K. Unger, E. Wolfgang, H. Harms, H. Haudek. J. Appl. Phys. 43, 6, 2875 (1972).
- [5] H. Gobel, E. Wolfgang, H. Harms. Phys. Stat. Sol. (a) 35, 1, 89 (1976).
- [6] Y.J. Wang, J.X. Shen, Q. Tang. J. Magn. Magn. Mater. 74, 3, 365 (1988).
- [7] A. Katsui, A. Shibukawa, H. Terui, K. Egashira. J. Appl. Phys. 47, 11, 5069 (1976).
- [8] Y. Chen, C.P. Luo, Z.T. Guan, Q.Y. Lu, Y.J. Wang. J. Magn. Magn. Mater. 115, 1, 55 (1992).
- [9] A. Katsui. J. Appl. Phys. 47, 10, 4663 (1976).
- [10] Y.J. Wang, J. Magn. Magn. Mater. **84**, 1–2, 39 (1990).
- [11] D.S. Dai, R.Y. Fang, P. Long, S. Zhang, T.J. Ma, C. Dai, X.X. Zhang. J. Magn. Magn. Mater. 115, 1, 66 (1992).
- [12] R. Coehoorn, R.A. de Groot. J. Phys. **F15**, 10, 2135 (1985).
- [13] J. Köhler, J. Kübler. J. Phys.: Condens. Mater. 8, 8681 (1996).
- [14] P.M. Oppeneer, V.N. Antonov, T. Kraft, H. Eschrig, A.N. Yaresko, A.Ya. Perlov. J. Appl. Phys. 80, 2, 1099 (1996).
- [15] D.K. Misemer. J. Magn. Magn. Mater. 72, 3, 267 (1988).
- [16] S.S. Jaswal, J.X. Shen, R.D. Kirby, D.J. Sellmyer. J. Appl. Phys. 75, 10, 6348 (1994).
- [17] Z.Q. Li, H.L. Luo, W.Y. Lai, Z. Zeng, Q.Q. Zheng. J. Magn. Magn. Mater. 98, 1–2, 47 (1991).
- [18] В.А. Середкин, В.Ю. Яковчук, Л.В. Буркова, С.З. Склюев. А.с. 1718273 СССР (1992).
- [19] M. Masuda, I. Izawa, S. Yoshino, S. Shiomi, S. Uchiyama. Jpn. J. Appl. Phys. 26, 5, 707 (1987).
- [20] D. Chen. J. Appl. Phys. 42, 9, 3625 (1971).
- [21] R.B. van Dover, E.M. Gyorgy, R.P. Frankenthal, M. Hong, D.J. Siconolfi. J. Appl. Phys. 59, 4, 1291 (1986).
- [22] А.С. Андреенко, Лин Жанда. ФТТ 30, 5, 1530 (1988).
- [23] G.A.N. Connell, S.J. Oh, J. Allen, R. Allen. J. Non-Cryst. Sol. 61–62, 1061 (1984).
- [24] P.O. Hedén, H. Löfgren, S.B.M. Hagström. Phys. Rev. Lett. 26, 8, 432 (1971).
- [25] N. Ahmed-Mokhtar, J.P. Petrakian, R. Philip, R. Fraisse, B. Lazarides. Thin Solid. Films 88, 2, 177 (1982).
- [26] R. Ahuja, S. Auluck, B. Johansson, M.S. Brooks. Phys. Rev. B50, 8, 5147 (1994).
- [27] G.A.N. Connell. J. Magn. Magn. Mater. 54-57, 1561 (1986).
- [28] J. Sticht, J. Kübler. Solid. State Commun. 53, 6, 529 (1985).
- [29] V.V. Nemoshkalenko, V.N. Uvarov, S.V. Borisenko, A.I. Senkevich, V.D. Borisenko. Металлофизика и новейшие технологии **17**, *10*, 3 (1995).
- [30] S. Labroo, N. Ali, P. Robinson. J. Appl. Phys. 67, 9, 5292 (1990).
- [31] K. Yoshimura, M. Shiga, Y. Nakamura. J. Phys. Soc. Jap. 55, 10, 3585 (1986).
- [32] H. Wada, H. Nakamura, K. Yoshimura, M. Shiga, Y. Nakamura. J. Magn. Magn. Mater. **70**, *1*–3, 134 (1987).
- [33] К. Тейлор, М. Дарби. Физика редкоземельных соединений. Мир, М. (1974). 374 с.
- [34] H. Tanaka, S. Takayama. J. Appl. Phys. 67, 9, 5334 (1990).
- [35] Ю.В. Князев, Г.А. Болотин. ФММ 58, 6, 1121 (1984).